

株洲中车时代半导体有限公司
ZHUSHOU CRRC TIMES SEMICONDUCTOR CO., LTD.KB_C 5200-22~28

双向晶闸管

Bidirectional Thyristor

版本: 2301

关键参数	Key Parameters	
V_{DSM}	2200~2800	V
$I_{T(AV)}$	2360	A
$I_{T(RMS)H}$	3710	A
I_{TSM}	38	kA
V_{TO}	0.99	V
r_T	0.16	mΩ

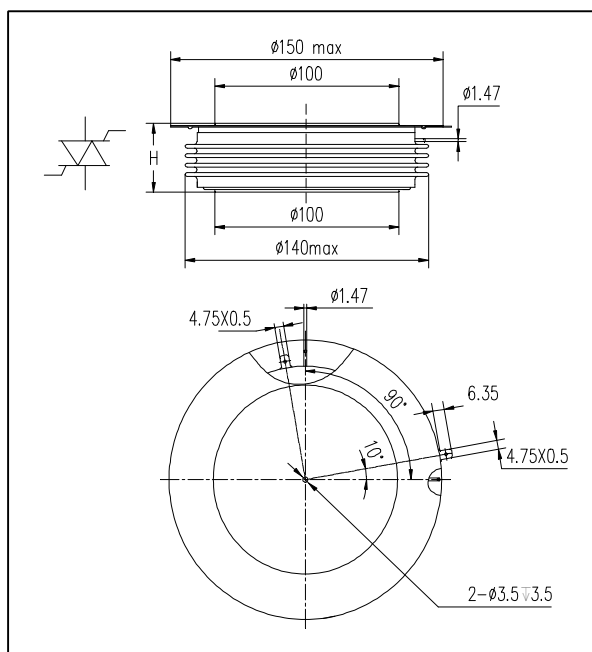
应用	Applications
●牵引传动	Traction drive
●电机驱动	Motor drive
●工业变流器	Industry converter

特点	Features
●两个晶闸管集成在一个硅片上	Two thyristors integrated into one wafer
●平板压装、双面冷却	Double-side cooling
●大功率容量	High power capability
●低损耗	Low loss

热和机械数据		Thermal & Mechanical Data			
符 号	参 数 名 称	最小	典型	最 大	单 位
R_{thJC}	结壳热阻	—	—	0.011	K/W
R_{thCH}	接触热阻	—	—	0.003	K/W
T_{vj}	内部等效结温	-40	—	115	°C
T_{stg}	贮存温度	-40	—	140	°C
F	紧固力	—	90	—	kN
H	高度	34.6	—	35.6	mm
m	质量	—	2.5	—	kg
a	紧压下加速度	—	—	100	m/s ²
	非紧压下加速度	—	—	50	m/s ²
D_S	爬电距离	—	58	—	mm
D_a	放电距离	—	24	—	mm

电压额定值	Voltage Ratings	
器 件 型 号	断态重复峰值 电压 V_{DRM}	测 试 条 件
KB _C 5200-22	2200	$T_{vj} = 25, 125\text{ °C}$
KB _C 5200-24	2400	$I_{DRM} \leq 400\text{ mA}$
KB _C 5200-26	2600	门极断路
KB _C 5200-28	2800	$V_{DM} = V_{DRM}$ $t_p = 10\text{ ms}$ $V_{DSM} = V_{DRM}$

外形图 Outline



电流额定值		Current Ratings				
符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	正弦半波, $T_C = 70\text{ °C}$	—	—	2360	A
$I_{T(RMS)H}$	通态方均根电流(正弦半波)	正弦半波, $T_C = 70\text{ °C}$	—	—	3710	A
$I_{T(RMS)F}$	通态方均根电流(正弦全波)	正弦全波, $T_C = 70\text{ °C}$	—	—	5240	A
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	$T_{vj} = 125\text{ °C}$, 正弦半波, 底宽10ms, $V_R = 0$	—	—	38.0	kA
I^2t	电流平方时间积	正弦波, 10ms	—	—	722	10 ⁴ A ² s

特性值

Characteristics

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
V_{TM}	通态峰值电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 3000\text{ A}$	—	—	1.47	V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $125\text{ }^{\circ}\text{C}$, V_{DRM} , 门极断路	—	—	400	mA
V_{TO}	门槛电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	0.99	V
r_T	斜率电阻	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	0.16	m Ω
I_H	维持电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	200	mA
I_L	擎住电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	1000	mA

动态参数

Dynamic Parameters

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
dv/dt	断态电压临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, 门极断路电压线性上升到 $0.67 V_{DRM}$	2000	—	—	V/ μ s
di/dt	通态电流临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $f = 50\text{ Hz}$ $I_{TM} = 3000\text{ A}$, $I_{FG} = 2\text{ A}$, $tr = 0.5\text{ }\mu$ s	—	—	250	A/ μ s
t_q	关断时间	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $I_T = 2000\text{ A}$ $dv/dt = 20\text{ V}/\mu$ s, $V_R = 200\text{ V}$, $-di/dt = 1.5\text{ A}/\mu$ s	—	400	—	μ s
Q_{rr}	反向恢复电荷	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-di/dt = 1.5\text{ A}/\mu$ s, $I_T = 2000\text{ A}$, $V_R = 200\text{ V}$	—	2300	—	μ C
dv/dt_{com}	换向电压临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_R \leq 0.67 V_{DRM}$	—	—	500	V/ μ s

门极特性

Gate Parameters

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
I_{GT}	门极触发电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	300	mA
V_{GT}	门极触发电压	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	3	V
V_{GD}	门极不触发电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 0.4 V_{DRM}$	0.3	—	—	V
V_{FGM}	门极正向峰值电压		—	—	12	V
V_{RGM}	门极反向峰值电压		—	—	10	V
I_{FGM}	门极正向峰值电流		—	—	10	A
P_{GM}	门极峰值功率		—	—	20	W
$P_{G(AV)}$	门极平均功率		—	—	4	W

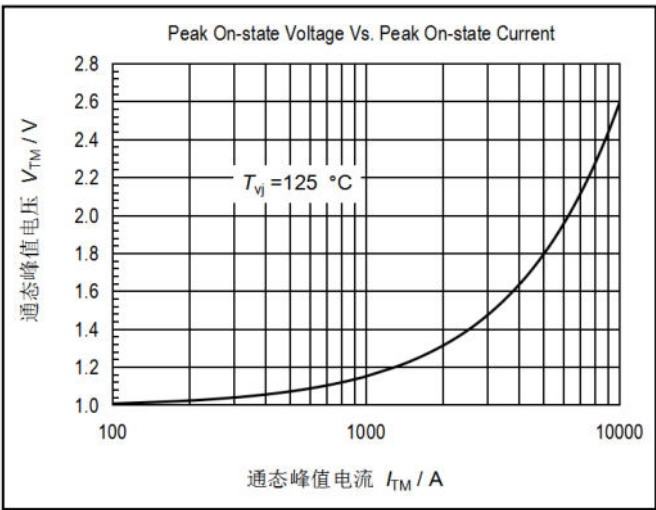


图1. 通态伏安特性曲线

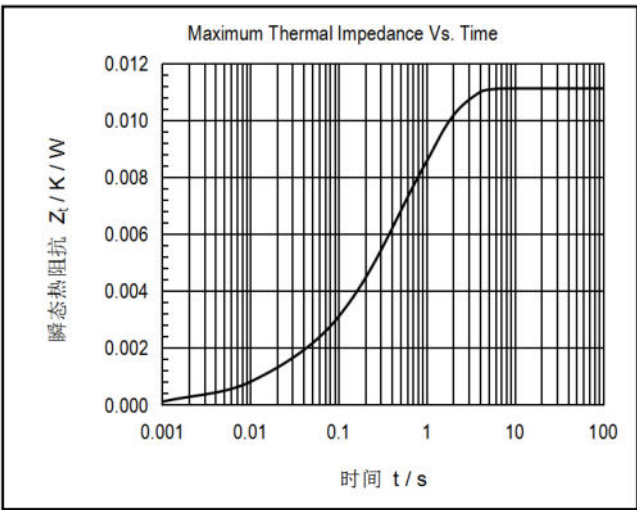


图2. 瞬态热阻抗曲线

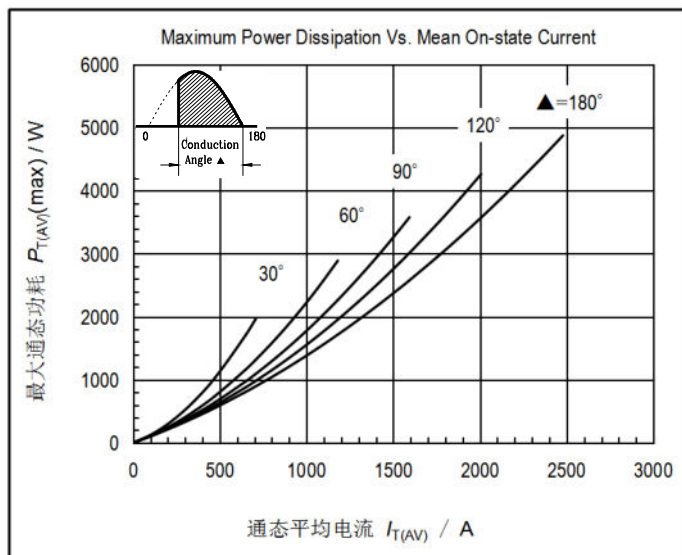


图3. 最大功耗与通态平均电流的关系曲线

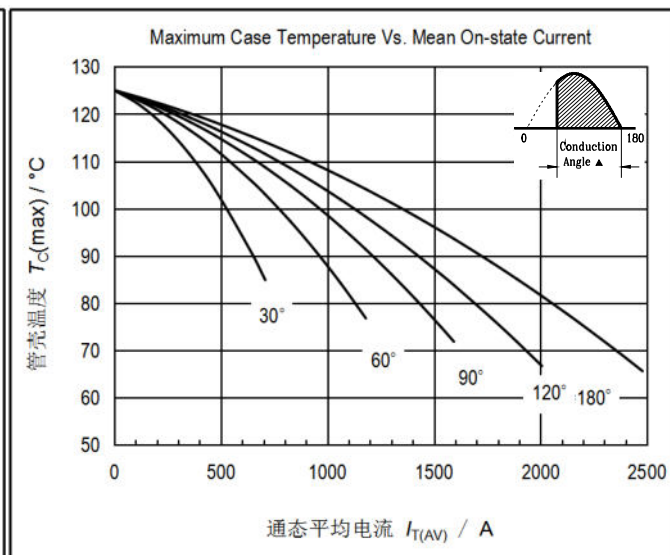


图4. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线

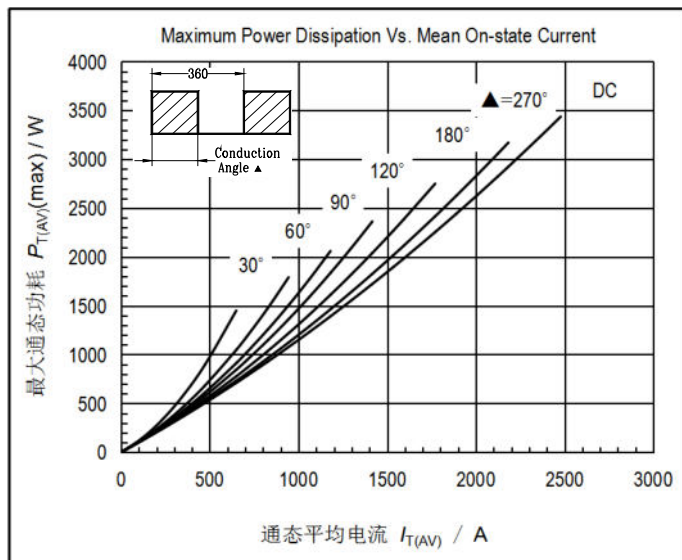


图5. 最大通态功耗与通态平均电流的关系曲线

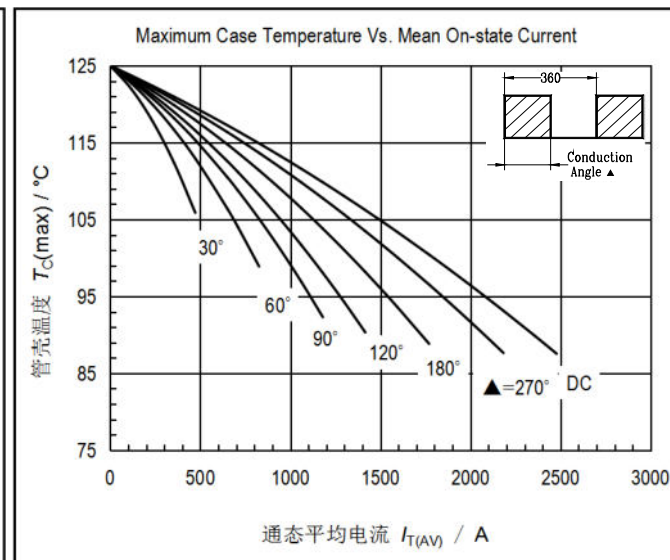


图6. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线

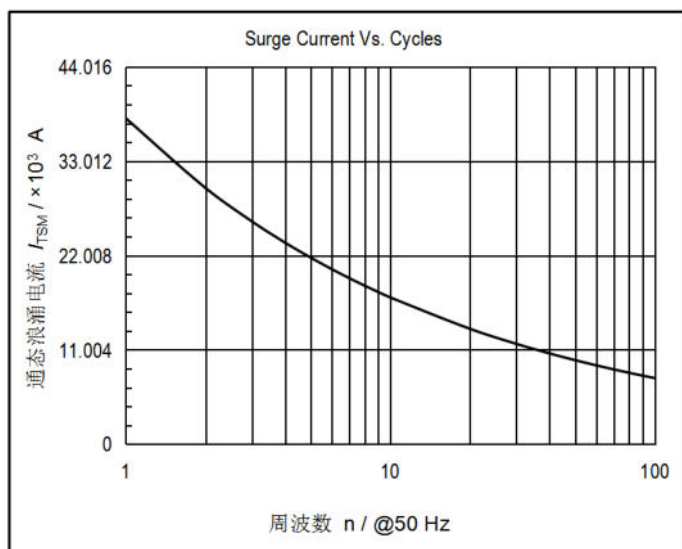


图7. 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

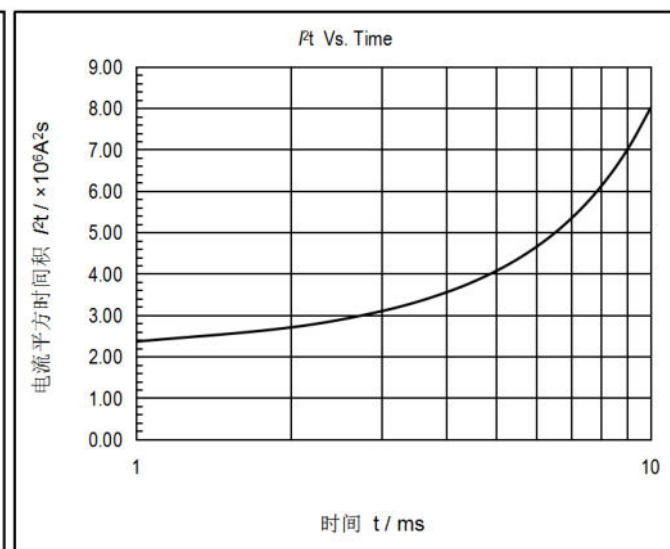


图8. I^2t 特性曲线

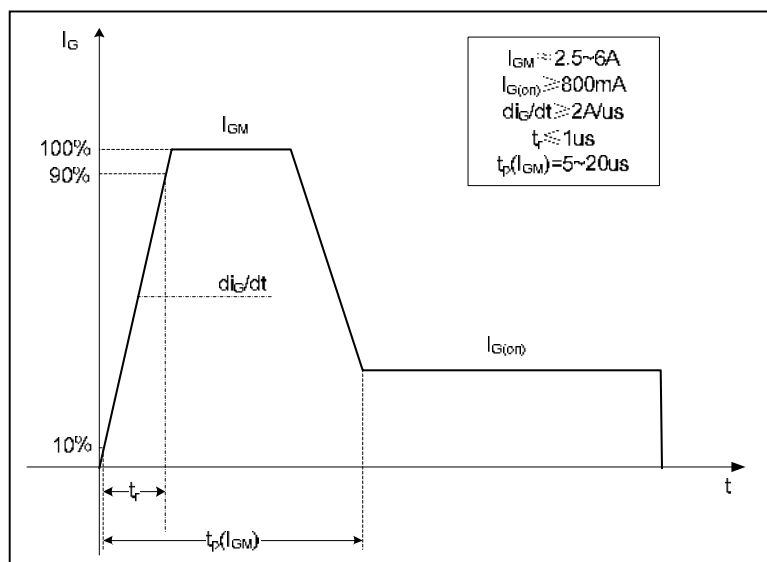


图9. 门极触发推荐波形

株洲中车时代半导体有限公司

Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co.,Ltd.

地 址	Address	湖南省株洲市田心工业园
邮 编	Zipcode	412001
电 话	Telephone	0731 - 28498268, 28498124
传 真	Fax	0731 - 28498851, 28498494
电子邮箱	Email	sbu@crreczic.cc
网 址	Web Site	www.sbu.crreczic.cc